

RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2022/1 de la Commission du 20 octobre 2021 modifiant le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des biens à double usage

(«Journal officiel de l'Union européenne» L 3 du 6 janvier 2022)

Page 142, dans l'annexe, le point 3B001.f est remplacé par le texte suivant:

«f. équipements de lithographie, comme suit:

1. photorépéteurs d'alignement et d'exposition (réduction directe sur la plaquette) ou photorépéteurs-balayeurs (scanners) pour le traitement de plaquettes utilisant des méthodes optiques ou à rayon X, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
 - a. longueur d'onde de la source lumineuse inférieure à 193 nm; ou
 - b. capables de produire des figures dont la dimension de l'élément résoluble minimal' (MRF) est égale ou inférieure à 45 nm;

Note technique:

La dimension de l'élément résoluble minimal' (MRF) est calculée à l'aide de la formule suivante:

$$MRF = \frac{\text{longueur d'onde de la source lumineuse d'exposition en nm}}{\text{ouverture numérique}} \times (\text{facteur } K)$$

où le facteur $K = 0,35$.

2. équipements de lithographie par impression capables de produire des éléments égaux ou inférieurs à 45 nm;

Note: L'alinéa 3B001.f.2. inclut:

- les outils d'impression par microcontact;
- les outils de gaufrage à chaud;
- les outils de lithographie par nanoimpression;
- les outils de lithographie par impression step and flash.

3. équipements spécialement conçus pour la production de masques et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
 - a. un faisceau électronique, un faisceau ionique ou un faisceau "laser" avec focalisation et balayage du faisceau; et
 - b. présentant l'une des caractéristiques suivantes:
 1. ayant une largeur à mi-hauteur (LMH) du spot inférieure à 65 nm et un placement d'image de moins de 17 nm (moyenne + 3 sigma); ou
 2. non utilisé;
 3. erreur de chevauchement pour la deuxième couche inférieure à 23 nm (moyenne + 3 sigma) sur le masque;
4. équipements conçus pour le traitement de dispositifs utilisant des méthodes d'écriture directe et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
 - a. un faisceau électronique avec focalisation et balayage du faisceau; et
 - b. présentant l'une des caractéristiques suivantes:
 1. une taille minimale du faisceau égale ou inférieure à 15 nm; ou
 2. une erreur de chevauchement inférieure à 27 nm (moyenne + 3 sigma);»